

# SAP/mSAP対応 ALPHO® LDF800シリーズ

For SAP mSAP process ALPHO® LDF800 series (under R&D)

For  
DI / LDI

## 特長 Features

- パッケージ用サブストレートの配線形成に適したh線DI露光に対応した高解像ドライフィルムフォトレジストです。  
High resolution Dry Film Photoresist suitable for patterning of Packaging substrate.  
Designed for h-line direct imaging exposure machine.
- 良好な剥離性及び柔軟性を有しているため、めっき潜り及びめっき後のレジスト残渣低減に優れています。  
LDF800 has good stripping ability and flexibility so it has excellent performance for reduction of under plating and resist residue.

## 使用例 Applications

- SAP, mSAP, SLP, Fine line etching

## レジスト特性 Resist Performance

Dry film	LDF815
レジスト厚 Resist Thickness (μm)	15
最少現像時間*1 Minimum Developing Time (sec.)	14
露光量*2 Exposure Energy (mJ/cm <sup>2</sup> )	61
ステップ段数 Photosensitivity (41SST)	14
解像密着性 Resolution and Adhesion (μm)	実測線幅：3.5 actual line width
独立細線密着性 Isolated Fine Line Adhesion (μm)	実測線幅：3.0 actual line width

\*1 現像条件 (Developing condition) : 1.0% Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, 30°C, 0.15MPa, M.D. x 2

\*2 DI露光 (Direct imaging exposure) : 株式会社オーク製作所製 GDi-MP (ORCMANUFACTURINGCO.,LTD) , Post exposure bake : 70°C, 30sec.

